

パワートランジスタ

2SD1541

T-33-11

2SD1541

シリコン NPN 三重拡散メサ形 / Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

水平偏向出力用 / Horizontal Deflection Output

■ 特徴 / Features

- ダンパダイオード内蔵。 / Built-in damper diode on chip
- ガラスパッシベーションによる高耐圧, 高信頼性。
High voltage and high reliability by glass passivation.
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching
- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)
- 放熱板への取付けがヒス1本で可能な“フルパック”パッケージ。
“Full Pack” package for simplified mounting only by a screw,
requires no insulator.

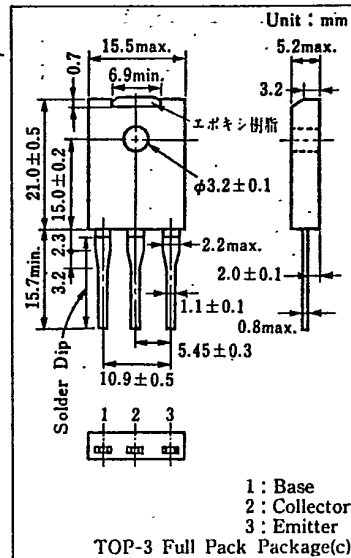
■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	5	V
コレクタ電流	I _C	3	A
せん頭コレクタ電流	I _{CP} *	10	A
せん頭ベース電流	I _{BP}	3.5	A
逆方向せん頭ベース電流	I _{BP}	-2.5	A
コレクタ損失 (T _c =25 °C)	P _C	50	W
接合部温度	T _j	130	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +130	°C

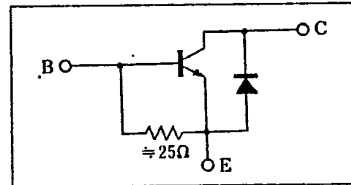
* 非線返しせん頭値

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (T_c=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =750 V, I _E =0			50	μA
		V _{CB} =1500 V, I _E =0			1	mA
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	I _E =500 mA, I _C =0	5			V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =10 V, I _C =2 A	4		12	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =2 A, I _B =0.75 A			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =2 A, I _B =0.75 A			1.5	V
下降時間	t _f	I _C =2 A, I _{Bend} =0.75 A			0.75	μs
蓄積時間	t _{stt}	L _{leak} =5 μH	3		7	μs
ダイオード順電圧	V _F	I _C =-4 A, I _B =0			2.2	V



内部接続図 / Connection Diagram



T-33-11

パワートランジスタ

2SD1541

